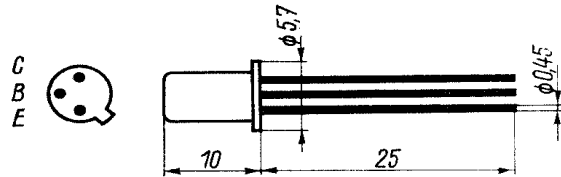


Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 für Niederfrequenz mit hoher Spannungsfestigkeit.



Masse ca. 0,8 g

Wärmewiderstand	R_{thja}	$\leq 0,38 \text{ grad/mW}$
Wärmewiderstand	R_{thjc}	$\leq 0,05 \text{ grad/mW}$

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CB0}$	$= 70 \text{ V}$
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER}$	$= 66 \text{ V}$
$R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$		
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	$= 15 \text{ V}$
Kollektorstrom	$-I_C$	$= 250 \text{ mA}$
Basisstrom	$-I_B$	$= 50 \text{ mA}$
Sperrschichttemperatur	θ_j	$= +80 \text{ }^\circ\text{C}$
Betriebstemperaturbereich		$-25 \text{ }^\circ\text{C bis } +65 \text{ }^\circ\text{C}$

Statische Kennwerte

		Min.	Typ	Max.	
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CB0}$		$9 \mu\text{A}$	$18 \mu\text{A}$	Stromverstärkungs- gruppe
$-U_{CB} = 15 \text{ V}$					
Kollektor-Emitter-Reststrom	$-I_{CER}$			$100 \mu\text{A}$	
$-U_{CER} = 66 \text{ V}$					
Emitter-Basis-Reststrom	$-I_{EBO}$		$12 \mu\text{A}$	$50 \mu\text{A}$	
$R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$					
$-U_{EB} = 10 \text{ V}$					
Kollektor-Basis-Stromverhältnis	h_{21E}	18		35	A
		28		56	B
$-U_{CE} = 0,5 \text{ V}$		45		90	C
$-I_C = 100 \text{ mA}$		71		140	D
h_{21E} -Verhältnis	$\frac{h_{21E 100}}{h_{21E 250}}$			1,3	
$h_{21E 100}$ bei $I_C = 100 \text{ mA}$					
$h_{21E 250}$ bei $I_C = 250 \text{ mA}$					

Dynamischer Kennwert

Grenzfrequenz	f_{h21e}	12 kHz
$-U_{CE} = 2 \text{ V}$		
$-I_C = 10 \text{ mA}$		

Bestellbeispiel für einen Transistor
der Stromverstärkungsgruppe C

Transistor GC 123 C

Transistoren in ruhender Luft

1. ohne Kühlblech
2. mit Kühlkörper TGL 200—8420 Form G
3. mit AL-Kühlblech, 2 mm dick, A = 9 cm²
vertikal, blank, unbearbeitet
4. vertikal, blank, unbearbeitet A = 25 cm²
5. vertikal, blank, unbearbeitet A = 100 cm²
6. mit angenähert idealer Kühlung

